



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 of The Patents Rules) क्रमांक : 044151239 SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 425409

आवेदन सं. / Application No. : 202041031742

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 24/07/2020

पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT

MADRAS)

आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.AMITAVA DAS GUPTA 2.M S RAMACHANDRA RAO

3.DELEEP R NAIR 4.MARTANDO RATH 5.AMAL DAS

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित METHOD TO REALIZE HIGHLY A-AXIS ORIENTED ALUMINIUM NITRIDE (ALN) THIN FILMS ON MO COATED SI SUBSTRATE BY REACTIVE RF MAGNETRON SPUTTERING नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जुलाई 2020 के चौबीसवें दिन से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled METHOD TO REALIZE HIGHLY A-AXIS ORIENTED ALUMINIUM NITRIDE (ALN) THIN FILMS ON MO COATED SI SUBSTRATE BY REACTIVE RF MAGNETRON SPUTTERING as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 24th day of July 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 16/03/2023 Date of Grant : पेटेंट चियंत्रक Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जुलाई 2022 के चौबीसवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 24th day of July 2022 and on the same day in every year thereafter.